

EasyPACK™ モジュール TRENCHSTOP™ IGBT7 と CoolSiC™ ショットキーダイオード内蔵と PressFIT / NTC サーミスタ

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 950\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 100\text{ A} / I_{CRM} = 200\text{ A}$
 - CoolSiC™ ショットキーダイオード gen5
 - 低スイッチング損失
 - トレンチ IGBT 7
- 機械的特性
 - 低熱インピーダンスの Al_2O_3 DCB
 - コンパクトデザイン
 - 内蔵された NTC サーミスタ
 - PressFIT 接合 技術



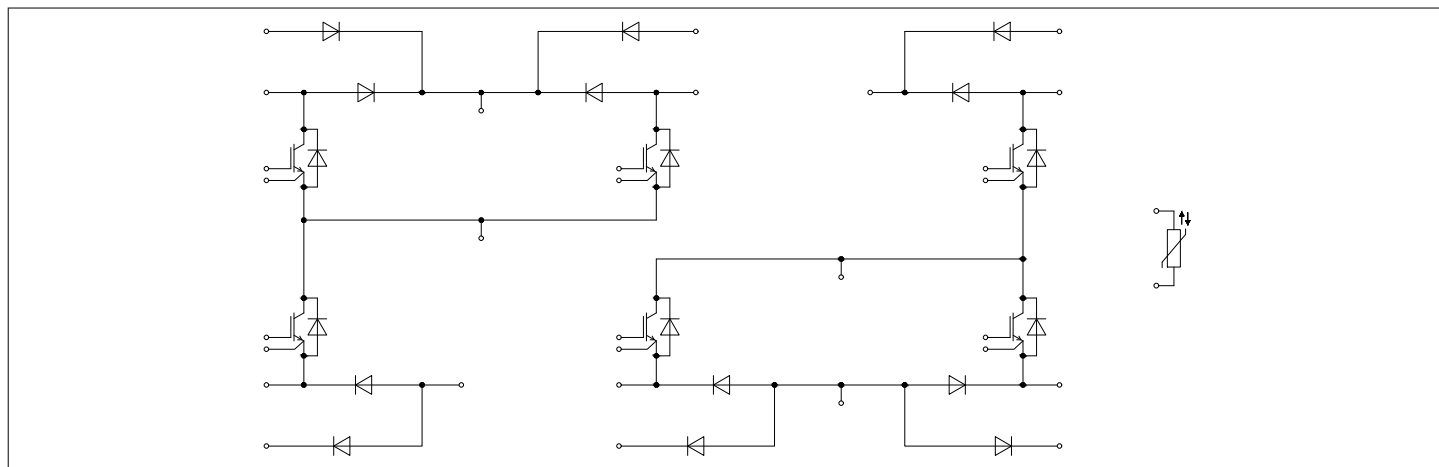
可能性のある用途

- UPS システム
- 3 レベル アプリケーション
- ソーラーアプリケーション

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



目次

	詳細	1
	特徴	1
	可能性のある用途	1
	製品検証	1
	目次	2
1	ハウジング	3
2	IGBT, ブースト	3
3	Diode, アップコンバータ	5
4	バイパスダイオード	5
5	逆極性保護 diode A	6
6	NTC-サーミスタ	7
7	特性図	8
8	回路図	13
9	パッケージ外形図	14
10	モジュールラベルコード	15
	改訂履歴	16
	免責事項	17

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
沿面距離	d_{Creep}	ターミナル - ヒートシンク間	11.2	mm
沿面距離	d_{Creep}	ターミナル - ターミナル間	6.8	mm
空間距離	d_{Clear}	ターミナル - ヒートシンク間	9.4	mm
空間距離	d_{Clear}	ターミナル - ターミナル間	5.5	mm
相対トラッキング指数	CTI		>400	
相対温度指数 (電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			22		nH
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	1.3		1.5	Nm
質量	G			78		g

注: The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

2 IGBT, ブースト

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	950	V
コレクタ電流	I_{CN}		100	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 175 \text{ °C}$ $T_H = 65 \text{ °C}$	70	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される	200	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}		±20	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 30\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.33	1.53	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.39		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1.40		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 1.67\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		4.35	5.10	5.85	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$			0.23		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			1.5		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			6.48		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.02		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 950\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.031	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 30\ A, V_{CE} = 500\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.060		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.060		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.060		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_C = 30\ A, V_{CE} = 500\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.020		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.020		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.020		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 30\ A, V_{CE} = 500\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.180		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.220		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.240		
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_C = 30\ A, V_{CE} = 500\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.080		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.120		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.130		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 30\ A, V_{CE} = 500\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 10\ \Omega, di/dt = 1900\ A/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.525		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.557		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.567		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 30\ A, V_{CE} = 500\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 10\ \Omega, dv/dt = 3500\ V/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.72		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.21		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1.37		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部(1素子当り), $\lambda_{grease} = 3.3\ W/(m^*K)$			0.667		K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$			-40		150	$^\circ C$

3 Diode, アップコンバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1200	V
順電流	I_{FN}		40	A
連続 DC 電流	I_F		30	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	80	A
電流二乗時間積	I^2t	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 30\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.29	1.63	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.49		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.61		
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$I_F = 30\text{ A}, V_R = 500\text{ V},$ $-di_F/dt = 1900\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	16.4		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	16.4		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	16.4		
逆回復電荷量	Q_r	$I_F = 30\text{ A}, V_R = 500\text{ V},$ $-di_F/dt = 1900\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.74		μC
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.74		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.74		
逆回復損失	E_{rec}	$I_F = 30\text{ A}, V_R = 500\text{ V},$ $-di_F/dt = 1900\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.249		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.249		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.249		
ジャンクション・ヒートシンク 間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 3.3\text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$		0.979		K/W
動作温度	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

4 バイパスダイオード

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1200	V
最大実効順電流/chip	I_{FRMSM}	$T_H = 95\text{ }^{\circ}\text{C}$	50	A
整流出力の最大実効電流	I_{RMSM}	$T_H = 95\text{ }^{\circ}\text{C}$	50	A

(続く)

表 7 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
サージ順電流	I_{FSM}	$t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	A
			$T_{vj} = 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$	

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 45 \text{ A}$ $T_{vj} = 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$		0.88		V
逆電流	I_r	$T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1200 \text{ V}$		1		mA
ジャンクション・ヒートシンク 間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 3.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		0.549		K/W
動作温度	$T_{vj, op}$		-40		110	$^{\circ}\text{C}$

5 逆極性保護 diode A

表 9 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	1200	V
最大実効順電流/chip	I_{FRMSM}	$T_H = 95 \text{ }^{\circ}\text{C}$	50	A
整流出力の最大実効電流	I_{RMSM}	$T_H = 95 \text{ }^{\circ}\text{C}$	50	A
サージ順電流	I_{FSM}	$t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	A
			$T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$	

表 10 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 30 \text{ A}$ $T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$		0.88		V
逆電流	I_r	$T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1200 \text{ V}$		0.1		mA
ジャンクション・ヒートシンク 間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 3.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		0.934		K/W
動作温度	$T_{vj, op}$		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

6 NTC-サーミスタ

表 11 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5		k Ω
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

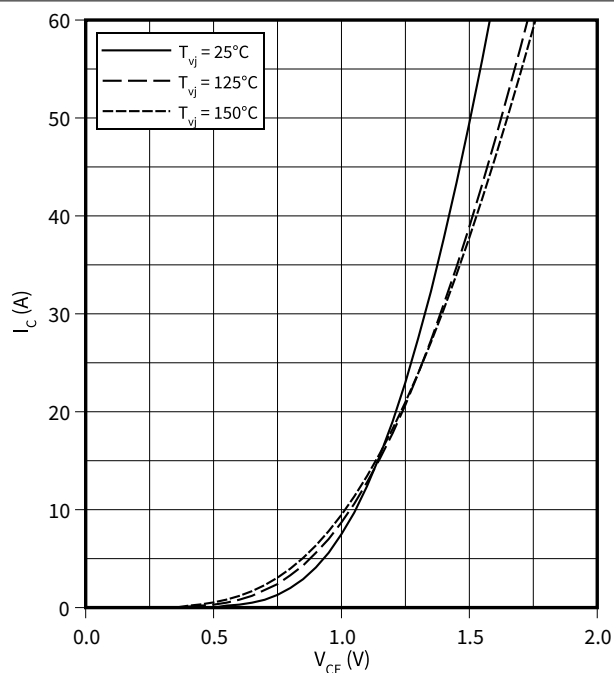
注: 適切なアプリケーションノートによる仕様

7 特性図

出力特性 (typical), IGBT, ブースト

$$I_C = f(V_{CE})$$

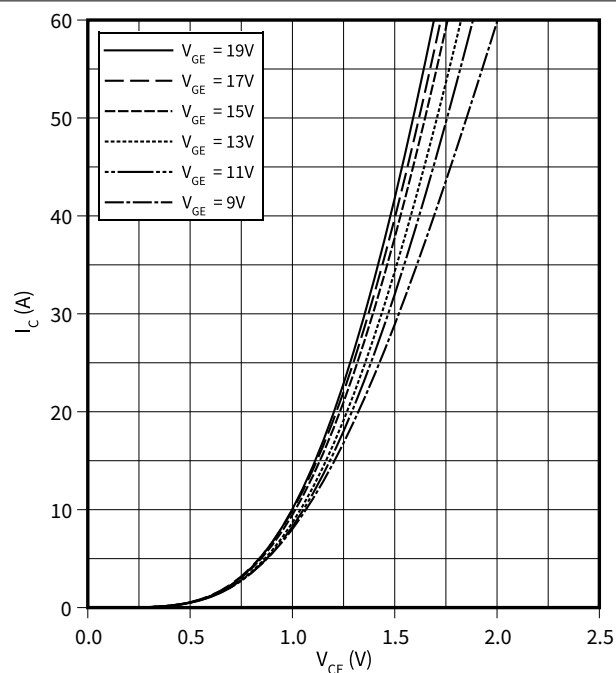
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



出力特性 (typical), IGBT, ブースト

$$I_C = f(V_{CE})$$

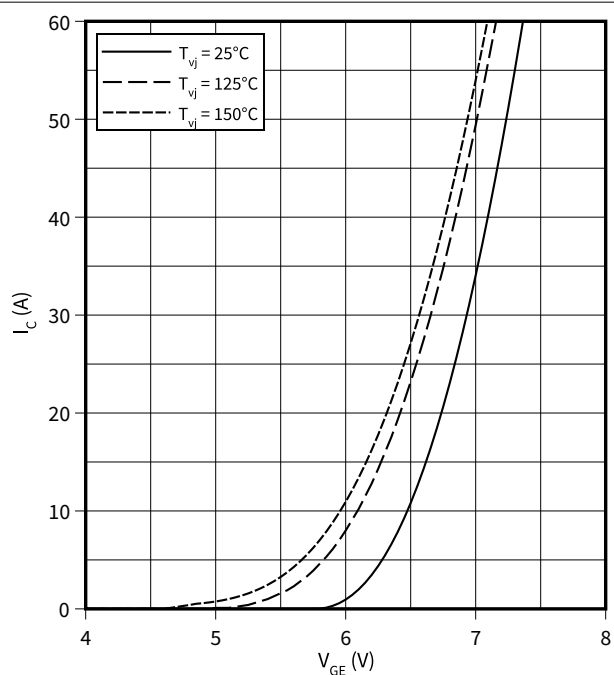
$$T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



伝達特性 (typical), IGBT, ブースト

$$I_C = f(V_{GE})$$

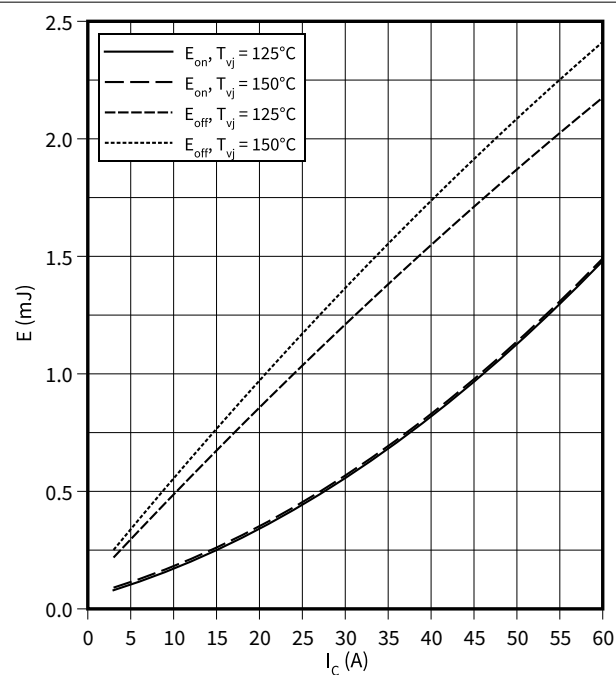
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



スイッチング損失 (typical), IGBT, ブースト

$$E = f(I_C)$$

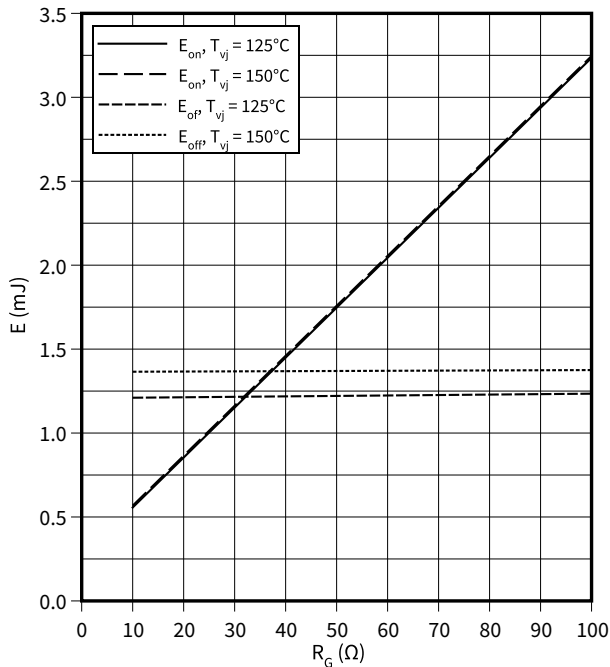
$$R_{Goff} = 10 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 10 \text{ } \Omega, V_{CE} = 500 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$



7 特性図

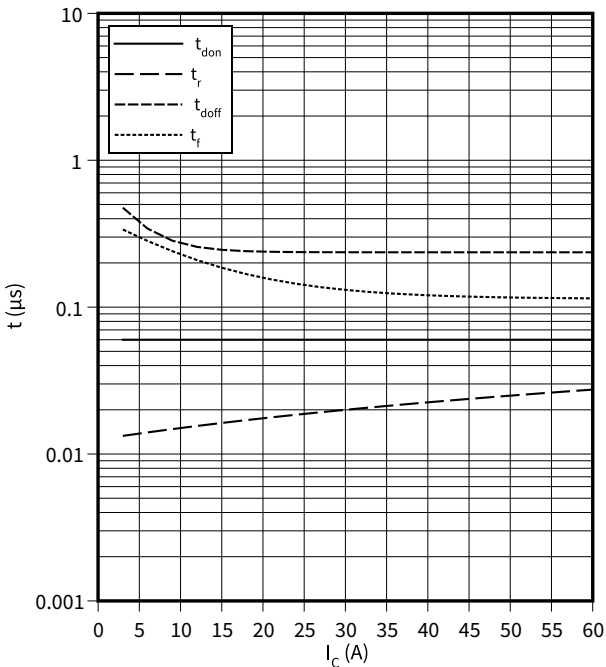
スイッチング損失 (typical), IGBT, ブースト

$E = f(R_G)$
 $I_C = 30\text{ A}$, $V_{CE} = 500\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



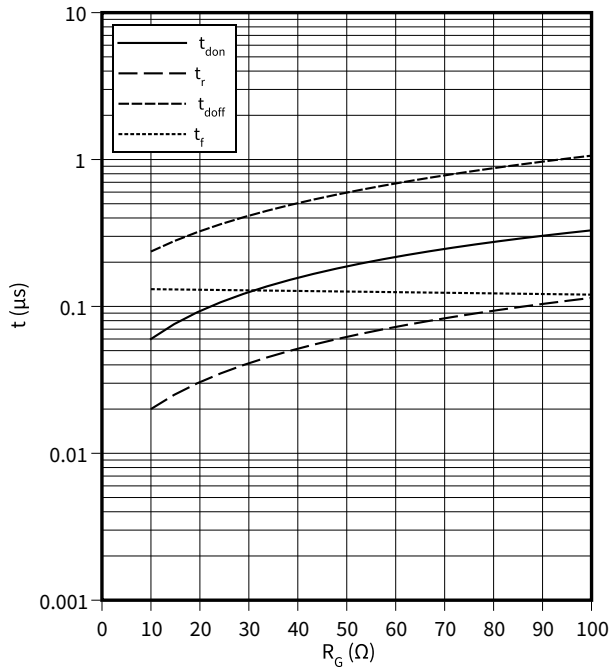
スイッチング時間 (typical), IGBT, ブースト

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$, $R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$, $V_{CE} = 500\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



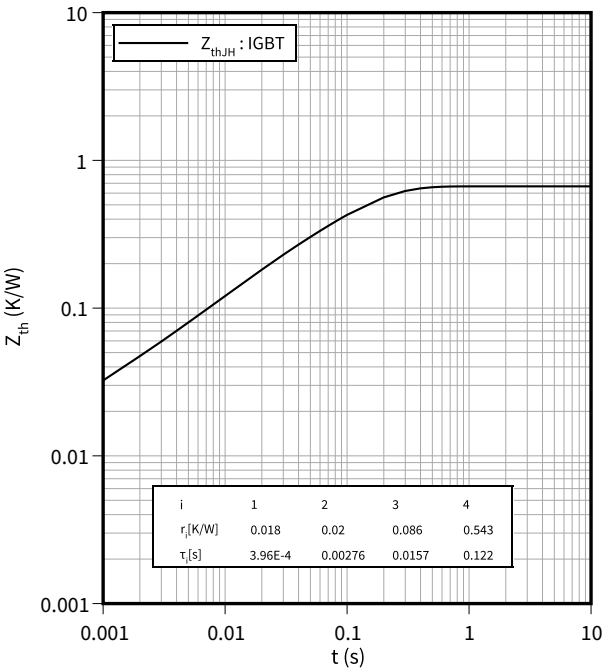
スイッチング時間 (typical), IGBT, ブースト

$t = f(R_G)$
 $I_C = 30\text{ A}$, $V_{CE} = 500\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



過渡熱インピーダンス, IGBT, ブースト

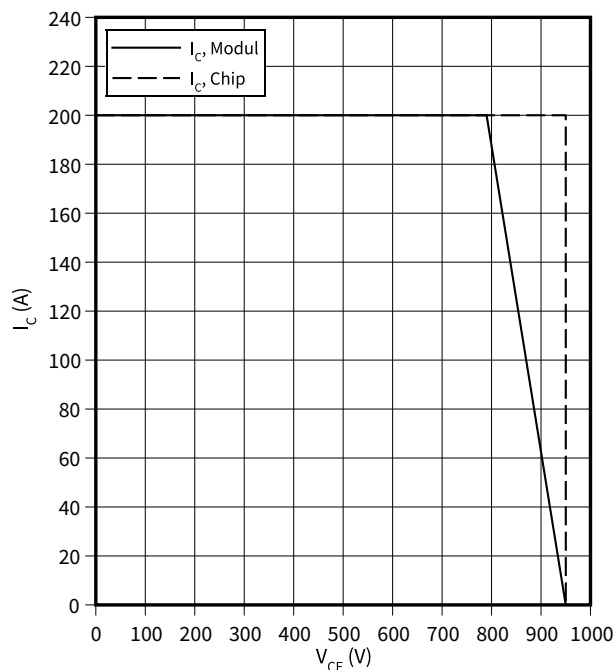
$Z_{th} = f(t)$



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, ブースト

$$I_C = f(V_{CE})$$

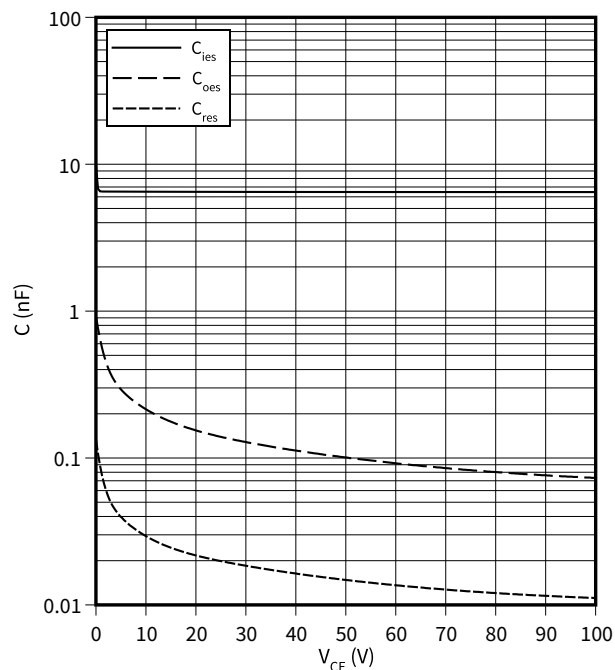
$$R_{Goff} = 10 \, \Omega, V_{GE} = \pm 15.0 \, V, T_{vj} = 150 \, ^\circ C$$



容量特性 (typical), IGBT, ブースト

$$C = f(V_{CE})$$

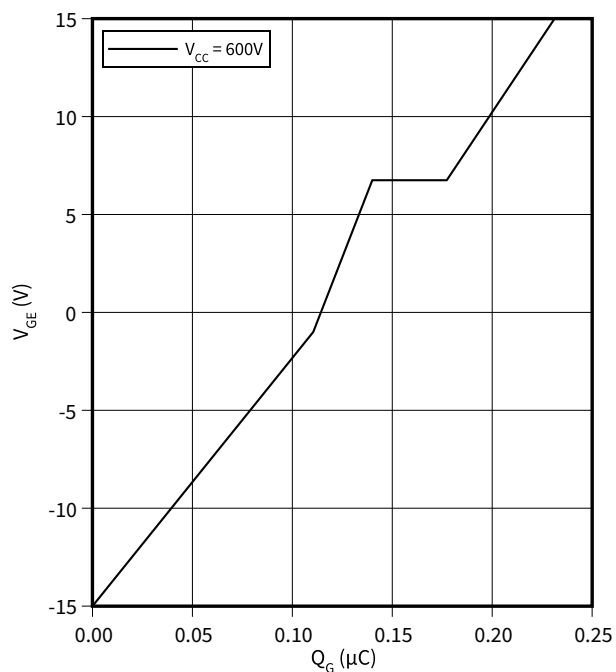
$$f = 100 \, kHz, V_{GE} = 0 \, V, T_{vj} = 25 \, ^\circ C$$



ゲート充電特性 (typical), IGBT, ブースト

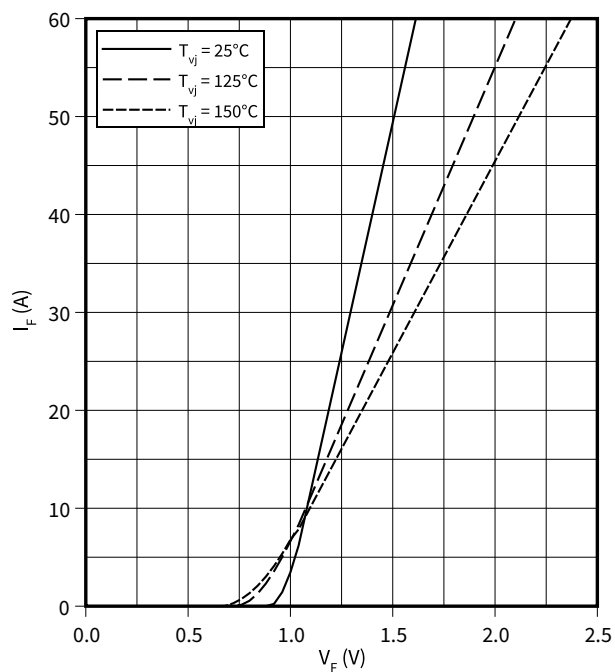
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 100 \, A, T_{vj} = 25 \, ^\circ C$$



順電圧特性 (typical), Diode, アップコンバータ

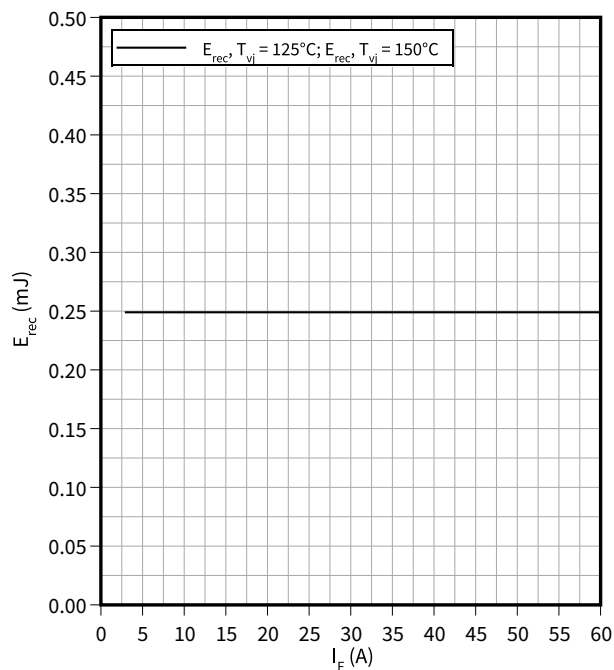
$$I_F = f(V_F)$$



スイッチング損失 (typical), Diode, アップコンバータ

$$E_{\text{rec}} = f(I_F)$$

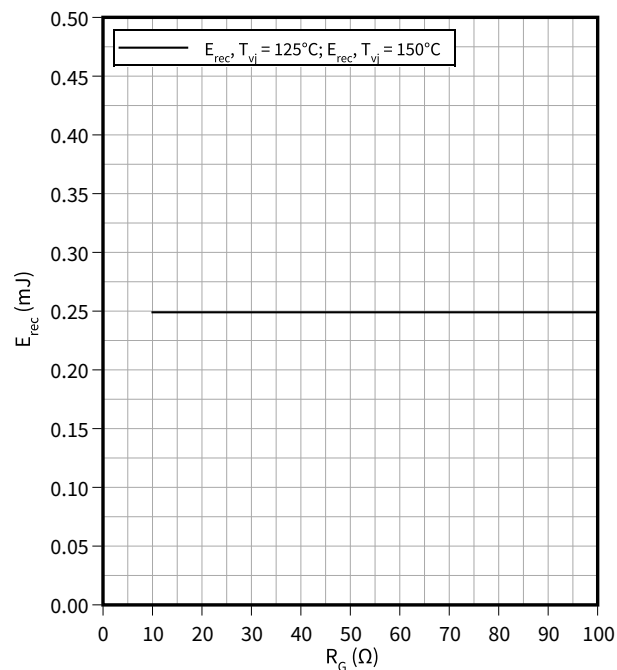
$$R_{\text{Gon}} = 10 \, \Omega, V_{\text{CE}} = 500 \, \text{V}$$



スイッチング損失 (typical), Diode, アップコンバータ

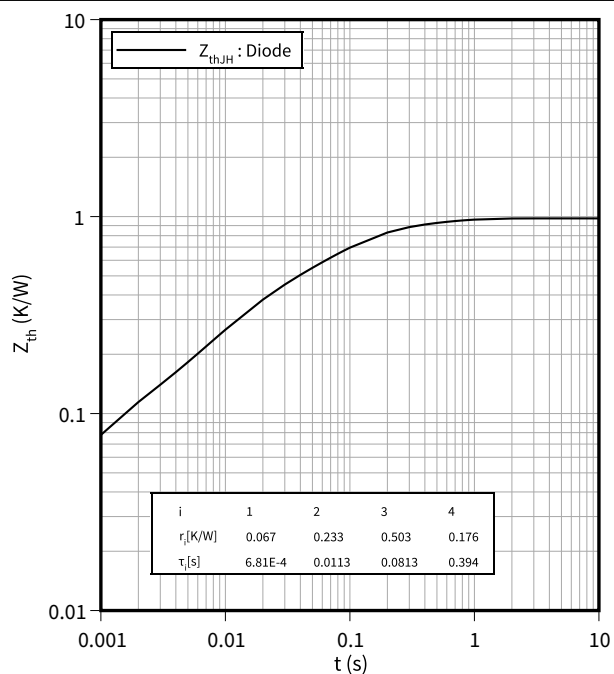
$$E_{\text{rec}} = f(R_G)$$

$$V_{\text{CE}} = 500 \, \text{V}, I_F = 30 \, \text{A}$$



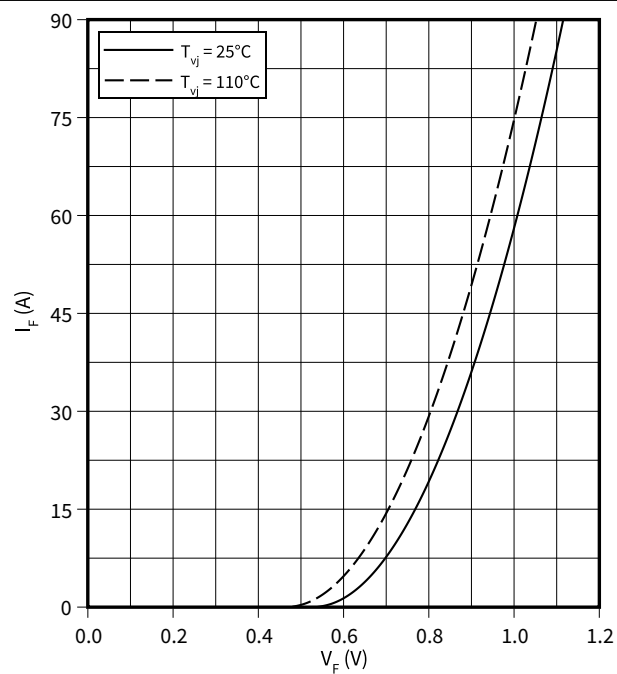
過渡熱インピーダンス, Diode, アップコンバータ

$$Z_{\text{th}} = f(t)$$



順電圧特性 (typical), バイパスダイオード

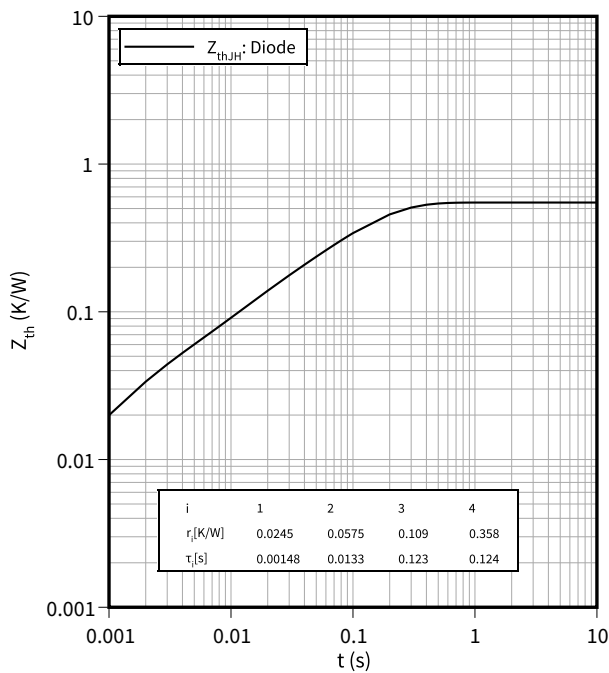
$$I_F = f(V_F)$$



7 特性図

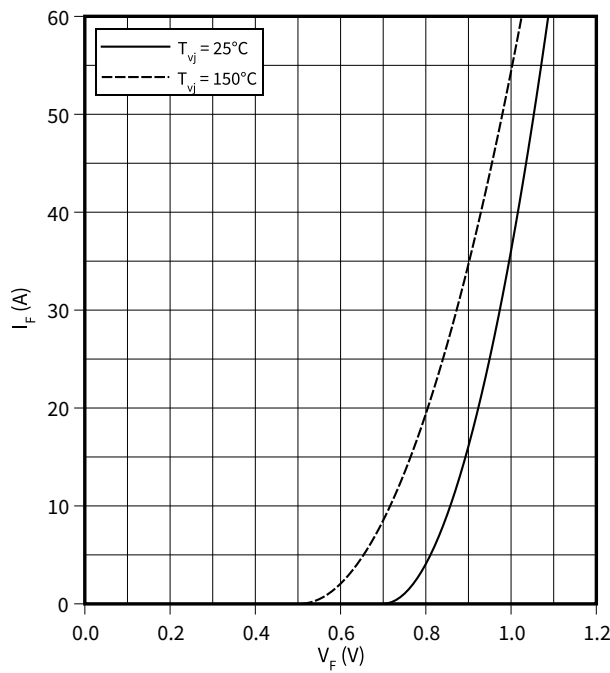
過渡熱インピーダンス, バイパスダイオード

$Z_{th} = f(t)$



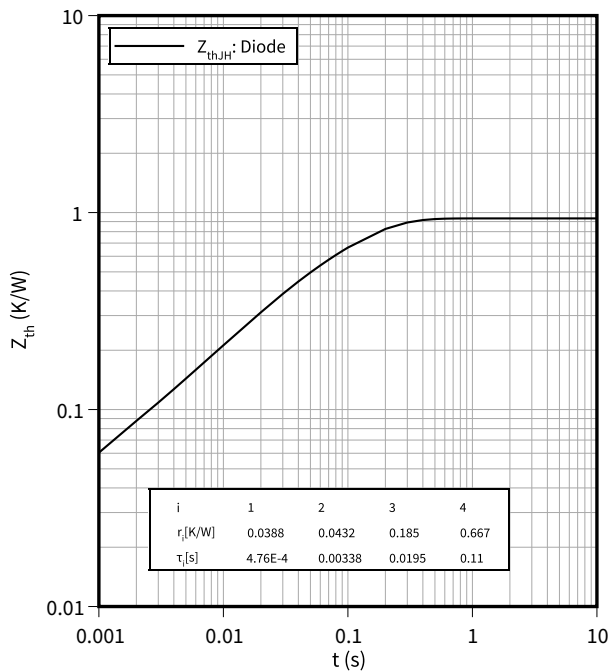
順電圧特性 (typical), 逆極性保護 diode A

$I_F = f(V_F)$



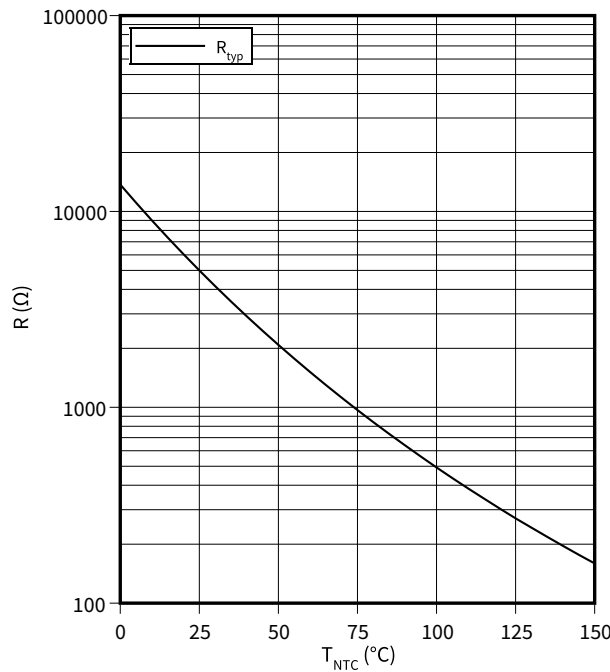
過渡熱インピーダンス, 逆極性保護 diode A

$Z_{th} = f(t)$



サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$R = f(T_{NTC})$



8 回路図

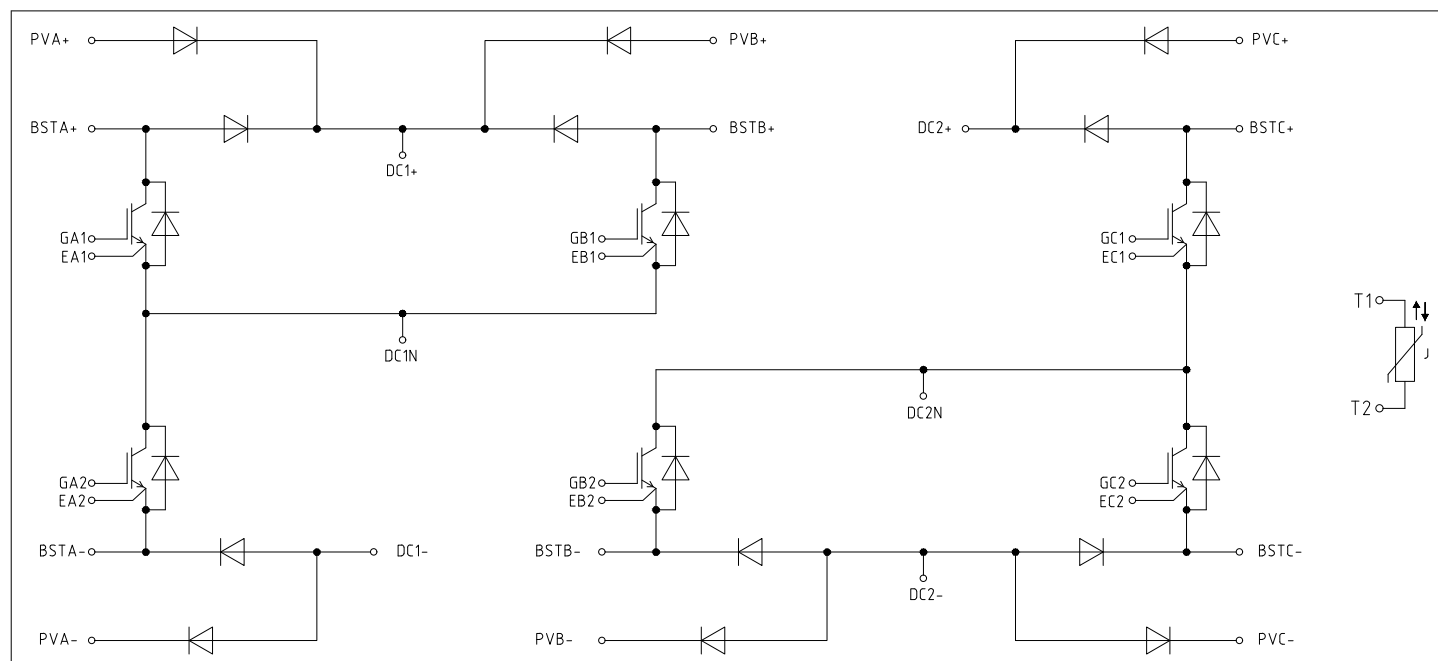


図 1

9 パッケージ外形図

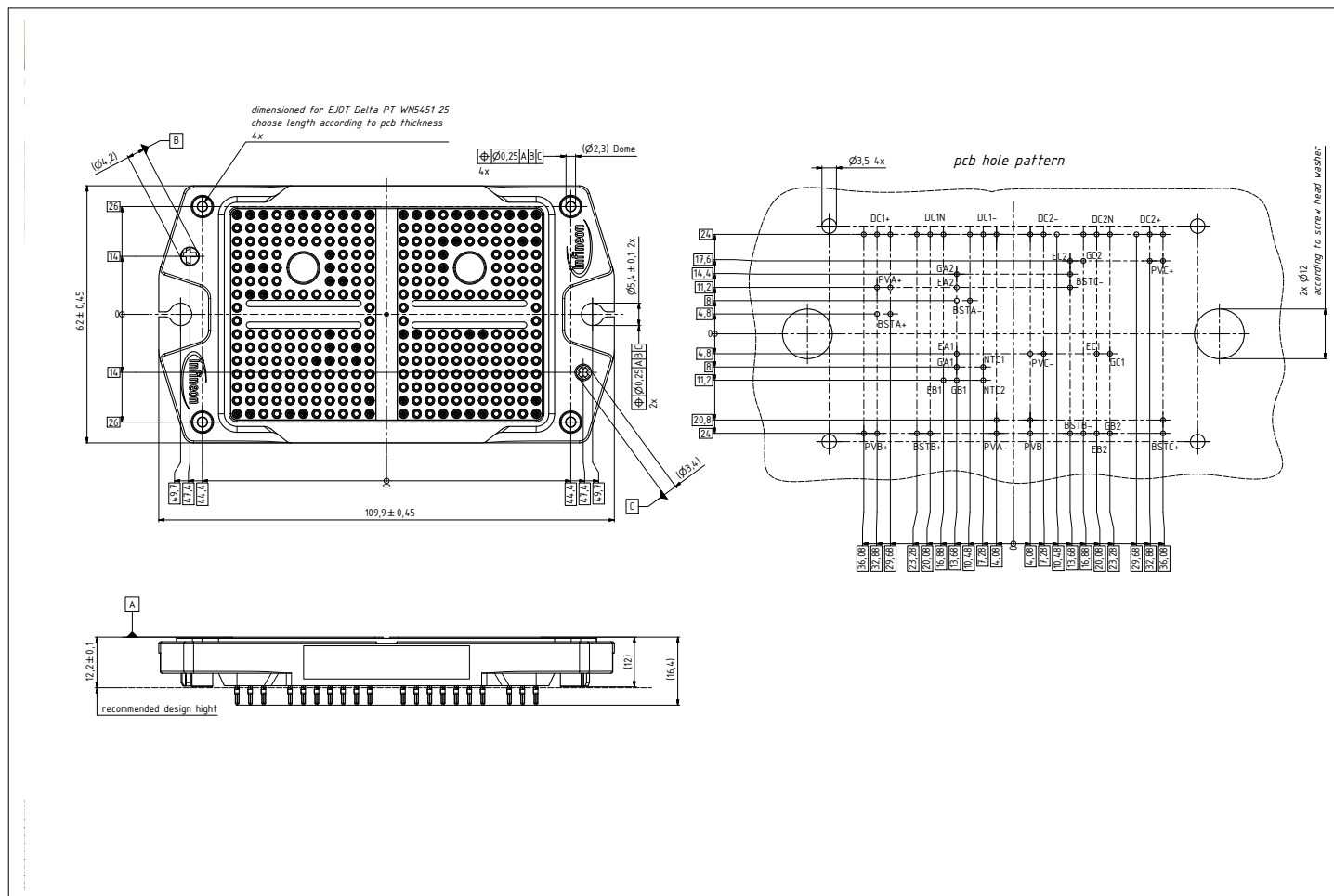


図 2

10 モジュールラベルコード



Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example			
			
71549142846550549911530		71549142846550549911530	

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2020-12-15	
1.00	2022-02-16	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-02-16

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAK566-002

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件 または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般 的価値、および／または本製品の用途に関する一切 の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以 下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所 有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様 の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品 の一切の使用に関し、本文書に記載された義 務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および 基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従 業員のみを対象としています。本製品の対象用途 への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に 記載された製品情報の完全性についての評価は、お 客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる 可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に 人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。